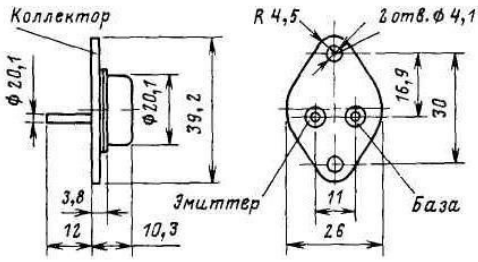


2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В, КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е

Транзисторы кремниевые меза-планарные *p-n-p* составные уни-версальные низкочастотные мощные

Предназначены для работы в усилителях низкой частоты, импульсных усилителях мощности, стабилизаторах тока и напряжения, повторителях, электронных системах управления, схемах автоматики и защиты

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами. Обозначение типа приводится на корпусе. Масса транзистора не более 20 г



Электрические параметры

Граничное напряжение при $I_3 = 100$ мА	
2Т825А	80 В
2Т825Б	60 В
2Т825В, КТ825Д	45 В
КТ825Г	70 В
КТ825Е	25 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер не более	
при $I_K = 10$ А, $I_B = 40$ мА	2 В
при $I_K = 20$ А, $I_B = 200$ мА	3* В
Напряжение насыщения база-эмиттер не более	
при $I_K = 10$ А, $I_B = 40$ мА	3 В
при $I_K = 20$ А, $I_B = 200$ мА	4* В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 10$ А	
при $T = 298$ К	
2Т825А	500—18 000
2Т825Б, 2Т825В, КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е	750—18 000
при $T = 398$ К	
2Т825А	400—25 000
2Т825Б, 2Т825В	600—25 000
при $T = 213$ К	
2Т825А	100—18 000
2Т825Б, 2Т825В	150—18 000
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером* при $U_{КБ} = 10$ В, $I_3 = 20$ А не менее	
	100
Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала* при $U_{КБ} = 3$ В, $I_3 = 10$ А, $f = 5$ кГц	
типичное значение	430—60 000
	1500
Время включения при $I_K = 10$ А, $I_B = 40$ мА не более	
типичное значение	1 мкс
	0,4* мкс
Время выключения при $I_K = 10$ А, $I_B = 40$ мА не более	
типичное значение	4,5 мкс
	3* мкс
Модуль коэффициента передачи тока при $U_{КБ} = 3$ В, $I_3 = 10$ А, $f = 1$ МГц не менее	
	4
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 10$ В, $f = 100$ кГц не более	
типичное значение	600 пФ
	350* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{БЭ} = 3$ В, $f = 100$ кГц не более	
типичное значение	600 пФ
	400* пФ
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при $U_{БЭ} = 1,5$ В не менее	
при $T = 298$ К, $I_K = 1$ мА	
2Т825А	100 В
2Т825Б	80 В
2Т825В, КТ825Д	60 В
КТ825Г	90 В
КТ825Е	30 В
при $T = 398$ К, $I_K = 5$ мА	
2Т825А	80 В
2Т825Б	60 В
2Т825В	50 В
при $T = 213$ К, $I_K = 5$ мА	
2Т825А	100 В
2Т825Б	80 В
2Т825В	60 В
Пробивное напряжение эмиттер-база при $I_3 = 2$ мА, не более	
	5 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 1$ кОм или $U_{БЭ} = 1,5$ В при $T_K = 213 - 328$ К
2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В и при $T_K = 233 - 328$ К
КТ825Г, КТ825Д, КТ825К

2Т825А	100 В
2Т825Б	80 В
2Т825В, КТ825Д	60 В
КТ825Г	90 В
КТ825Е	30 В

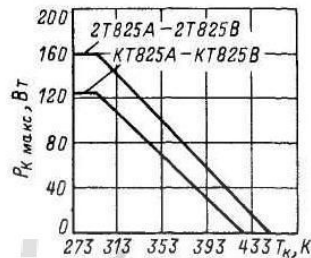
Постоянное напряжение база-эмиттер 5 В
Постоянный ток коллектора 20 А

Импульсный ток коллектора
2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В 40 А
КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е 30 А

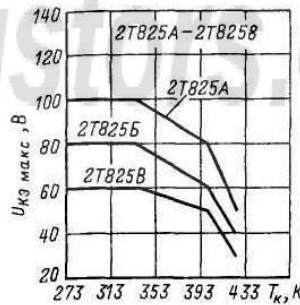
Постоянный ток базы 0,5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В при $T_K \leq 298$ К 160 Вт
КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е при $T_K \leq 298$ К 125 Вт
без тепловода при $T = 298$ К 3 Вт

Температура перехода
2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В 448 К
КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е 423 К

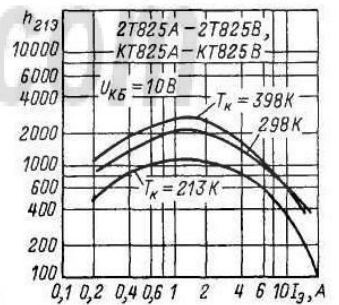
Температура окружающей среды
2Т825А, 2Т825Б, 2Т825В От 213 до $T_K = 398$ К
От 233 до $T_K = 373$ К
КТ825Г, КТ825Д, КТ825Е От 233 до $T_K = 373$ К



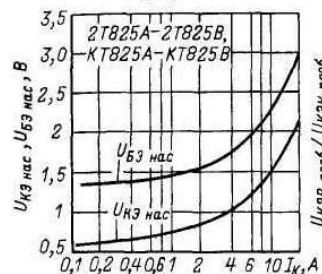
Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса



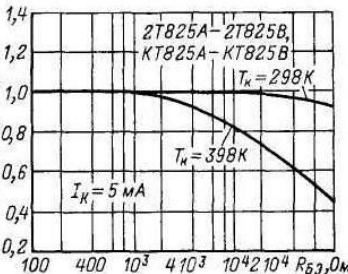
Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от температуры корпуса



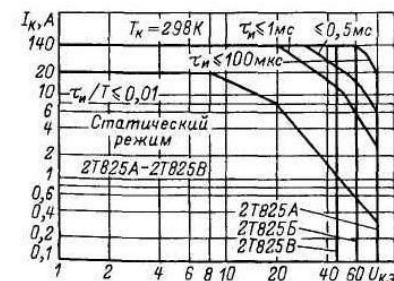
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



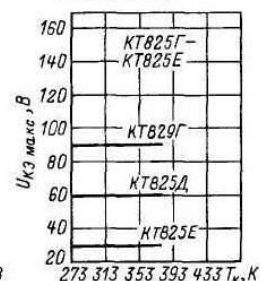
Зависимость напряжений насыщения коллектор-эмиттер и база-эмиттер от тока коллектора



Зависимость относительного пробивного напряжения коллектор-эмиттер от сопротивления база-эмиттер



Область максимальных режимов



Зависимость максимально допустимого напряжения коллектор-эмиттер от температуры корпуса